

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2021年8月26日(26.08.2021)



(10) 国際公開番号

WO 2021/166991 A1

- (51) 国際特許分類:
B32B 37/02 (2006.01) H01L 21/683 (2006.01)
B32B 37/12 (2006.01) H01L 21/301 (2006.01)
B32B 37/16 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2021/006067
- (22) 国際出願日: 2021年2月18日(18.02.2021)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2020-028103 2020年2月21日(21.02.2020) JP
- (71) 出願人: リンテック株式会社 (LINTEC CORPORATION) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町2 3 番 2 3 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 中石 康喜 (NAKAISHI Yasunobu); 〒1730001 東京都板橋区本町2 3 番 2 3 号 リンテック株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 西澤 和純, 外(NISHIZAWA Kazuyoshi et al.); 〒1006620 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM,

(54) Title: BACK-SURFACE-PROTECTION-FILM FORMING COMPOSITE, METHOD FOR MANUFACTURING FIRST LAMINATED BODY, METHOD FOR MANUFACTURING THIRD LAMINATED BODY, AND METHOD FOR MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICE EQUIPPED WITH BACK SURFACE PROTECTION FILM

(54) 発明の名称: 裏面保護膜形成用複合体、第一積層体の製造方法、第三積層体の製造方法、及び裏面保護膜付き半導体装置の製造方法



(57) Abstract: A back-surface-protection-film forming composite (1) that is formed by laminating a back-surface-protection-film forming film (13) on a protection layer (12) is used for a method for manufacturing a first laminated body, said method including: a first lamination step for bonding the back-surface-protection-film forming film (13) to a back surface of a semiconductor substrate to obtain a second laminated body in which the semiconductor substrate, the back-surface-protection-film forming film (13), and the protection layer (12) are laminated in that order; a curing step for curing the back-surface-protection-film forming film (13) of the second laminated body to obtain a back surface protection film; and a transportation step for transporting the second laminated body from the first lamination step to the curing step, whereby the first laminated body includes the semiconductor substrate, the back surface protection film, and the protection layer (12) that are laminated in that order.

(57) 要約: 保護層(12)と、裏面保護膜形成用フィルム(13)とが積層されてなる裏面保護膜形成用複合体であって、半導体基板の裏面に、裏面保護膜形成用フィルム(13)を貼付して、前記半導体基板と、裏面保護膜形成用フィルム(13)と、保護層(12)とがこの順に積層された第二積層体を得る第一の積層工程と、前記第二積層体の裏面保護膜形成用フィルム(13)を硬化させて裏面保護膜とする硬化工程と、前記第一の積層工程から前記硬化工程に前記第二積層体を搬送する搬送工程とを含む、前記半導体基板と、前記裏面保護膜と、保護層(12)とがこの順に積層された第一積層体の製造方法に用いられる、裏面保護膜形成用複合体(1)。

WO 2021/166991 A1

[続葉有]

ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

一 国際調査報告（条約第21条(3)）